2020-2021-1 大学物理 AII 期末考试题 A 卷参考答案和评分标准

一、选择题(共24分,单选,每题3分)

C B C C B CD

- 二、填空题(共30分)
- 1. $D = \frac{Q}{4\pi R^2}$; 1分 指向球壳中心; 1分 $\frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{\varepsilon_{r_1} R_1} \frac{1}{\varepsilon_{r_2} R} + \frac{1}{\varepsilon_{r_2} R} \frac{1}{\varepsilon_{r_2} R_2} \right)$ 2分
- 2. $\frac{2\pi\varepsilon_0[(\varepsilon_r 1)h + H]}{\ln R \ln r}$ 3 $\frac{4}{2}$
- 3. 1.5mH
- 4. $q = 2.04 \times 10^{-11}C$ (数值从 2.0~2.1 都可算对) 3分
- 5. 感生电场和位移电流 或变化的磁场产生感生电场和变化的电场产生感生磁场;

 $\iint_{c} \frac{\partial}{\partial t} \vec{D} \cdot d\vec{S} \stackrel{\mathbf{d}}{\otimes} \frac{d}{dt} \iint_{c} \vec{D} \cdot d\vec{S} \stackrel{\mathbf{d}}{\otimes} d\Phi_{D} / dt \; ; \quad - \iint_{c} \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \cdot d\vec{S} \stackrel{\mathbf{d}}{\otimes} - \frac{d}{dt} \iint_{c} \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \cdot d\vec{S} \stackrel{\mathbf{d}}{\otimes} - d\Phi_{m} / dt$

2分 6.9472m; 2分 能。 2分

7. $\frac{h}{\sqrt{3}m_0c}$ 3分

8. -0.85eV; 2分 4 1分

9. 6.6×10⁻⁸; 2分 1.84×10⁻⁵ 1分

三、计算题(共46分)

1. M: (1) P 点总的电场强度为零。该点的电场强度是导体球面上非均匀分布的电荷及 球外点电荷 q 所共同产生的。于是所求场强等于总场强减去球 外点电荷 q 产生的场强。

场强: $E'_p = 0 - \frac{q}{4\pi\epsilon_o r^2}$ 方向沿r指向q 2分

P点的电势是导体球面上非均匀分布的感应电荷 q'及球外点电荷 q 共同产生的,于是, 所求电势等于总电势减去球外点电荷 q 产生的电势。

$$\varphi_p' = \varphi_p - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$
 2 \(\phi\)

导体达到静电平衡后,P点电势与O相等,即 $\varphi_p = \varphi_o = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_0}$

电势:
$$\varphi_p' = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_0} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$
 2 分

(2) 若球接地,导体球心
$$O$$
 处的电势为零,即 $\varphi_o=0$ 2分

$$\therefore \varphi_O = \varphi_O' + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_0} \quad , \qquad \varphi_O' = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R} \qquad \therefore q' = -\frac{R}{r_0} q \qquad \qquad 2 \implies$$

2. 解:(1)要求载流平面单位面积所受的磁场力,须首先求出外磁场的磁感应强度。由图所示磁感线疏密可知 $B_2 > B_1$,已知无限大载流平面两侧磁场大小相等,皆为

$$B_{\pm} = B_{\pm} = \frac{\mu_0}{2} j \qquad 1 \text{ }$$

方向相反。式中j表示无限大载流平面内通过垂直于电流方向的单位长度的电流强度。均匀外磁场 B_0 在平面两侧方向相同,故由叠加原理可得

$$B_0 - B_{\pm} = B_1$$
 , $B_0 + B_{\pm} = B_2$ 1

外磁场的磁感应强度大小为
$$B_0 = \frac{B_1 + B_2}{2}$$
,方向竖直向下。 2分

(2) 面电流密度大小为
$$j = \frac{1}{\mu_0} (B_2 - B_1)$$
, 方向垂直于纸面向里。 2分

(3)设电流方向为y方向,磁场方向为x方向,则载流平面内电流元 IdI_y 在磁场中受力

$$df = Idl_{y} \times B$$
 1 分

$$Idl_v$$
 在磁场中受力大小为 $df = jdl_v \cdot dl_v B_0$ 1 分

则载流平面单位面积受磁场力大小为

$$F = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}l_x \cdot \mathrm{d}l_y} = jB_0 = \frac{\left(B_2^2 - B_1^2\right)}{2\mu_0},$$
 1 \(\frac{\psi}{2}\)

方向垂直于载流平面指向
$$B_1$$
一侧。 1分

3. 解: (1) n 为金属框所围面积的法向,设时间 t=0 时,n 与 B 的夹角为 0;

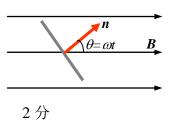
则 t 时刻通过金属框所围面积的磁通量为

$$\Psi_{\rm m}(t) = BS\cos\theta = BS\cos\omega t$$
 2 \(\frac{1}{2}\)

其中 S 为梯形面积

金属框中电动势为 $\varepsilon = BS\omega\sin\omega t$

当金属框线圈平面与磁力线平行时, $\omega t=\pi/2$ 代入上式得

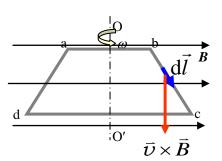


$$\varepsilon = B S \cos i \left(\frac{\pi}{2} \right) = B S \approx 3B \approx 10$$

(2) bc 边的动生电动势为

$$\varepsilon_{bc} = \int_{(b)}^{(c)} \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l}$$
$$= \int_{0}^{4} \left(\frac{ab}{2} + l \sin 30^{\circ} \right) \omega B \cdot dl \cdot \cos 30^{\circ}$$

 $=4\sqrt{3}B\omega\times10^{-4}[V]$ c点电势高。



直接写出 $\varepsilon_{bc} = \frac{1}{2}\varepsilon = 4\sqrt{3}B\omega \times 10^{-4}$ [V] 也可以。

3分

金属框中 b 点与 c 点之间的电势差为

$$U_{\rm bc} = I_i \frac{R}{4} - \varepsilon_{\rm bc} = \frac{\varepsilon}{R} \times \frac{R}{4} - \varepsilon_{\rm bc} = -2\sqrt{3}B\omega \times 10^{-4} [V] \, . \tag{2}$$

4. 解: (1) 由归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(x)|^2 dx = \int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = 1$$
 2 \(\frac{1}{2}\)

归一化常数
$$A$$
 为 $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$ 1 分

在 a/4<x<a 区间内发现粒子的概率为

$$P = 1 - \int_0^{\pi/4} |\psi_1(x)|^2 dx = 1 - \int_0^{\pi/4} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) dx = 1 - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi}\right) = 0.909$$
 2 \(\frac{\psi}{a}\)

(2) 对宽为 a 的一维无限深方势阱中粒子的势能 U(x)=0

由一维定态薛定谔方程 $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+U(x)\psi=E\psi$ 可得

$$\frac{\mathrm{d}^2 \psi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi = 0$$
 2 \(\frac{\phi}{\phi}\)

代入
$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

$$-\sqrt{\frac{2}{a}}\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \sin\frac{n\pi}{a}x + \frac{2m}{\hbar^2}\sqrt{\frac{2}{a}}E\sin\frac{n\pi}{a}x = 0$$

由此得无限深方势阱中粒子的能量为

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n^2 = \frac{h^2}{8ma^2} n^2; \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

另一种方法:

一维无限深方势阱中粒子的德布罗意波干涉,产生驻波,波长满足

$$a = n (\lambda/2)$$
 2 β

所以
$$p_n = \frac{h}{\lambda} = \frac{nh}{2a} = \frac{n\pi\hbar^2}{a}$$
 2分

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$
 1 \(\frac{\psi}{2}\)

5. 解: (1) 由势能曲线,由于当 $x\rightarrow 0$ 时,电势 $\varphi\rightarrow +\infty$,因 此有一正电荷位于坐标原点处,设其电量为 Q_1 。

又由于电势曲线在正 x 轴上无发散, 所以另一点电荷一 定位于 x 负半轴上; 又由于在 x 正半轴坐标为 x₀ 处电势为 零,因此另一点电荷一定是负电荷,且其量值大于正点电荷 Q_1 , 设其电荷量的大小为 Q_2 , 则 $Q_2 > Q_1$,

(2) 设点电荷 Q_2 到原点的距离为 d。

$$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 x_0} - \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 (x_0 + d)} = 0$$

$$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 ax_0} - \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 (ax_0 + d)} = -\varphi_0$$
 1 \(\frac{1}{2}\)

由于 $x=ax_0$ 处电势为极小,如果放一正的检验电荷在此处,其电势能也为极小值, 说明该点是检验电荷的平衡位置,位于该点的检验电荷受力为零,因此有

$$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 (ax_0)^2} - \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 (ax_0 + d)^2} = 0 \qquad 1 \text{ }$$

联立以上三式解得:

$$d = a(a-2)x_0, \qquad Q_1 = \frac{4\pi\varepsilon_0 ax \, \varphi}{a-2}, \qquad Q_2 = \frac{4\pi\varepsilon_0 a(a-1^2) \, x\varphi}{a-2}.$$